

TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO  
TECNOLÓGICO DE  
SALTILLO

# AC REPORTE

## Practica 3

TecNM Campus Saltillo

Mauro Emanuel Alvarado Vazquez

21051384

Ingeniería en Sistemas Computacionales

4to Semestre



### **Tipos de Memoria Ram:**

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory): fue el primer tipo de memoria RAM sincronizada con el bus de la placa madre. Tiene una velocidad de reloj más alta y una latencia más baja que la memoria RAM anterior, lo que la hace más rápida y eficiente.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory): es una mejora de SDRAM que duplica la tasa de transferencia de datos en comparación con la SDRAM original. DDR SDRAM es capaz de transferir datos dos veces por ciclo de reloj, lo que la hace más rápida que la SDRAM.

DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory): es una mejora de DDR SDRAM que utiliza una tecnología más avanzada y una latencia más baja para aumentar aún más la velocidad y la eficiencia.

DDR3 SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory): es una mejora de DDR2 SDRAM que utiliza una velocidad de reloj más alta y una latencia más baja para mejorar aún más el rendimiento y la eficiencia.

DDR4 SDRAM (Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random Access Memory): es la última versión de DDR SDRAM y utiliza una velocidad de reloj aún más alta y una latencia más baja para mejorar la velocidad y la eficiencia de la memoria.

### **Practica**

La práctica consistió en probar diferentes módulos de memoria ram en los equipos para verificar que funcionaran correctamente; los módulos de memoria que funcionan correctamente están marcados con un ángulo, los que no están marcados con una equis o no están marcados.

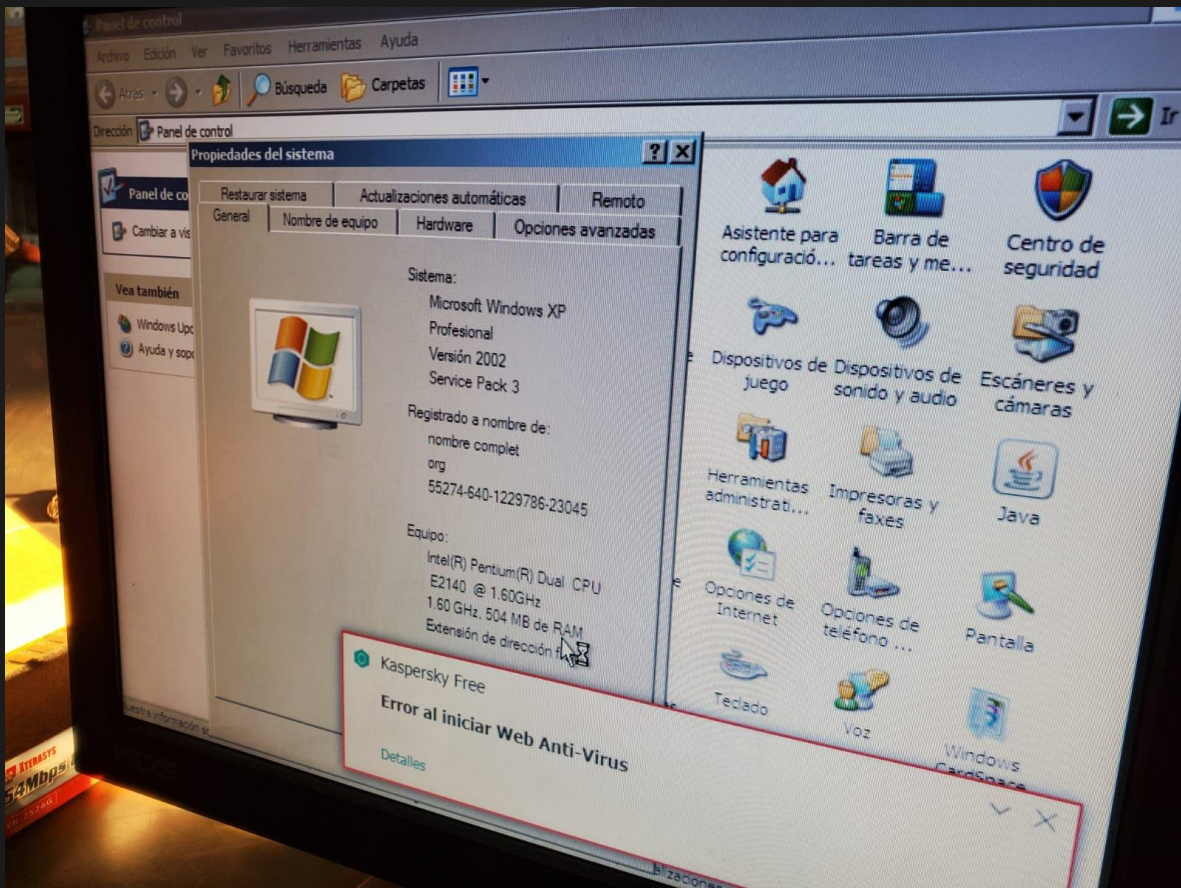
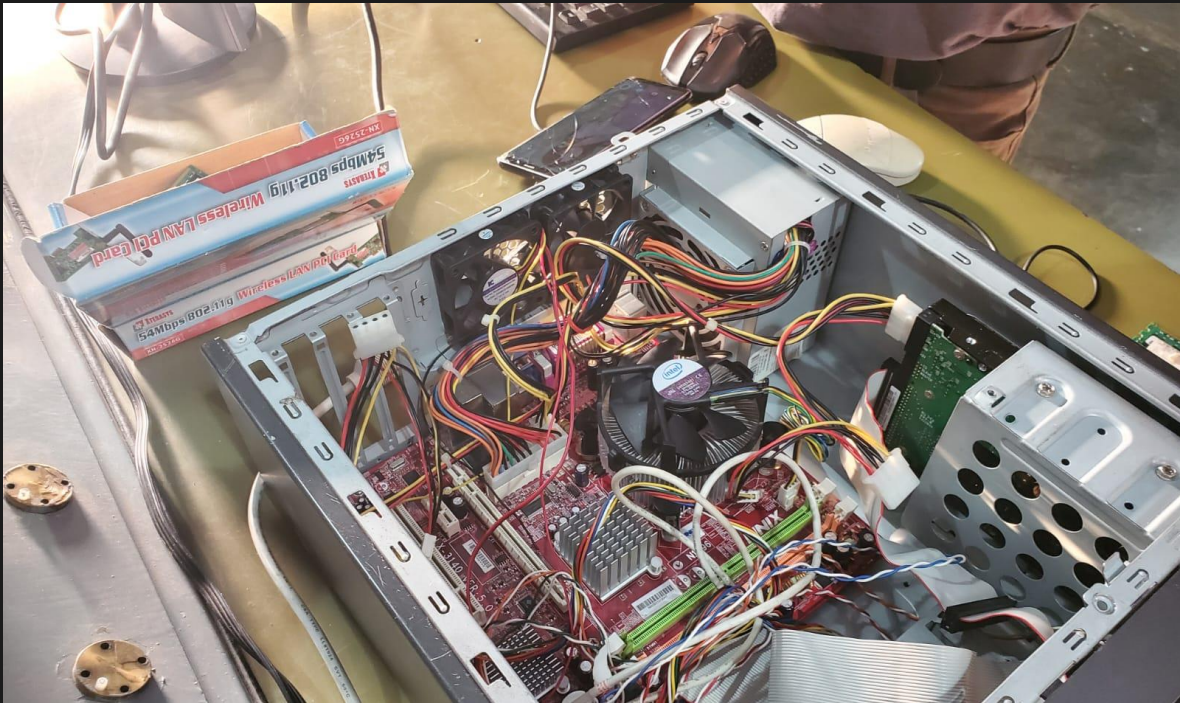
Adjunto fotografías de la practica e, información de algunos módulos de memoria.

### REPORTE PRACTICA 3



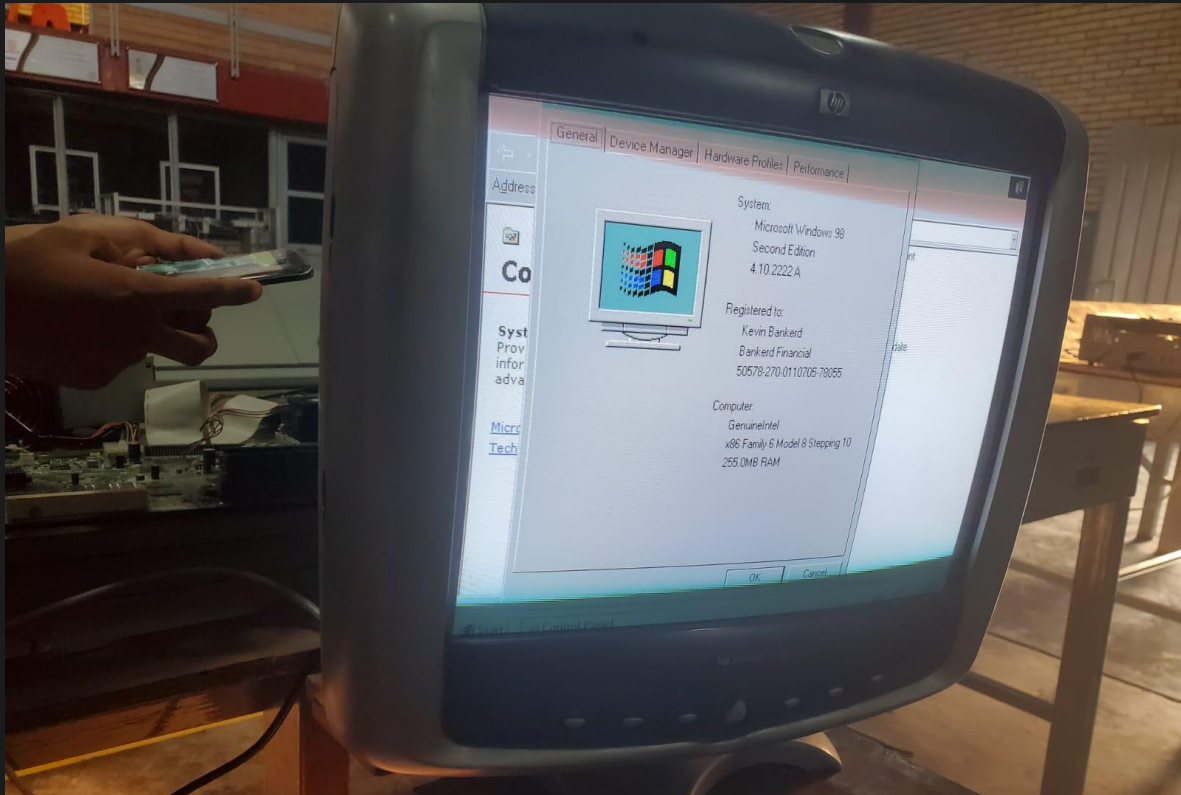


## REPORTE PRACTICA 3





### REPORTE PRACTICA 3



Velocidad: PC133 se refiere a una velocidad de bus de 133 MHz. Esto significa que puede transferir datos a una velocidad máxima de 133 millones de ciclos por segundo. Es importante tener en cuenta que la velocidad de la memoria RAM debe ser compatible con la velocidad del bus de la placa madre de la computadora.

### REPORTE PRACTICA 3

Capacidad: UNM PC133 CL3 viene en módulos de memoria con capacidad de 128 megabytes.

Latencia: CL3 significa que la latencia CAS (Column Address Strobe) es de 3 ciclos.

Voltaje: UNM PC133 CL3 utiliza un voltaje de 3.3 voltios.



tipo específico de memoria RAM DDR2

Velocidad: PC2-3200R se refiere a una velocidad de bus de 400 MHz, que se multiplica por 2 para obtener una velocidad efectiva de 800 MHz.

Capacidad: 1Rx8 significa que el módulo tiene un solo rango de fila y utiliza ocho chips de memoria RAM. El número "1" indica que solo hay un módulo de memoria en el canal de memoria. La capacidad de un este módulo de memoria es de 521 MB

Voltaje: 1Rx8 PC2-3200R utiliza un voltaje de 1.8 voltios.



Capacidad: El módulo de memoria tiene una capacidad de 128 megabytes (MB).

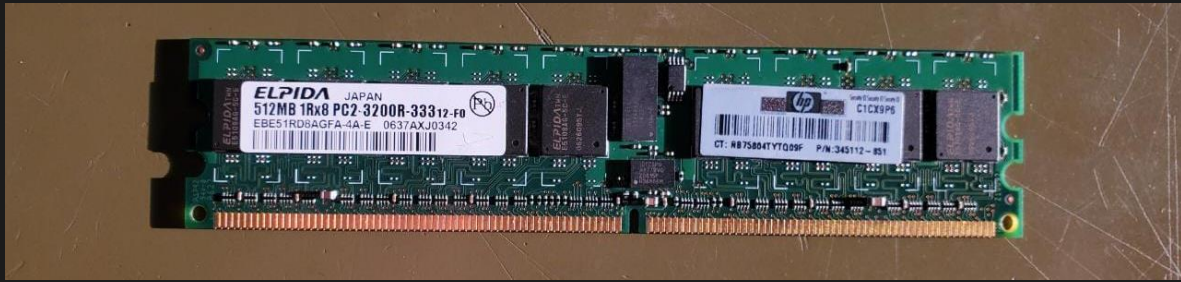
Velocidad: El módulo de memoria es de tipo PC2700, lo que significa que tiene una velocidad de bus de 333 MHz. Al ser DDR SDRAM, la velocidad efectiva se multiplica por 2, por lo que la velocidad de transferencia de datos es de 667 MHz.

Latencia: El módulo de memoria tiene una latencia CAS (Column Address Strobe) de 2.5 ciclos. La latencia CAS se refiere al tiempo que tarda la memoria en acceder a una columna de datos específica dentro del módulo de memoria.

Voltaje: El módulo de memoria utiliza un voltaje de 2.5 voltios.



## REPORTE PRACTICA 3



Capacidad: Este modulo es de capacidad 512MB

Velocidad: PC2-3200R se refiere a una velocidad de bus de 400 MHz, que se multiplica por 2 para obtener una velocidad efectiva de 800 MHz. Esto significa que puede transferir datos a una velocidad máxima de 800 millones de ciclos por segundo.

Voltaje: 1Rx8 PC2-3200R utiliza un voltaje de 1.8 voltios.

Letra de revisión: La letra "F" en la denominación del modelo hace referencia a la revisión específica del módulo de memoria y no tiene un significado estándar.



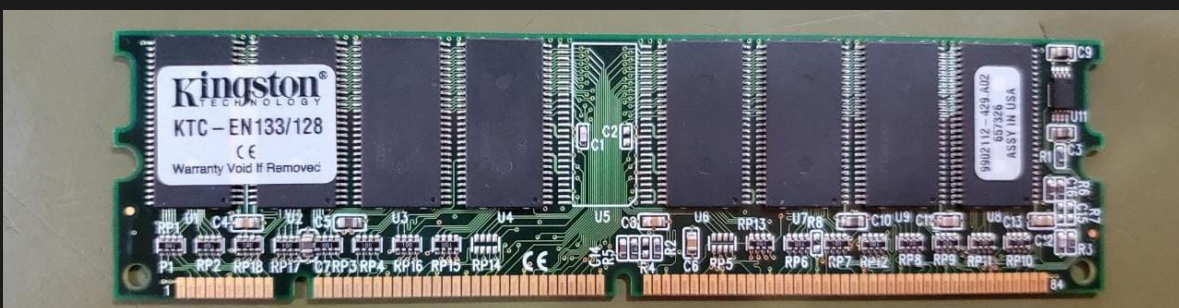
## REPORTE PRACTICA 3



Velocidad: KVR667D2N5/2G funciona a una velocidad de reloj de 667 MHz. La velocidad real de transferencia de datos es de 5,3 GB/s (667 MHz x 8 canales de datos / 8 bits por canal).

Capacidad: Como su nombre lo indica, esta memoria tiene una capacidad total de 2 GB.

Latencia: El tiempo de latencia de KVR667D2N5/2G es CL5, lo que significa que su latencia CAS (Column Address Strobe) es de 5 ciclos de reloj. Esto representa la cantidad de tiempo que tarda la memoria en acceder a una columna de datos específica dentro del módulo de memoria.





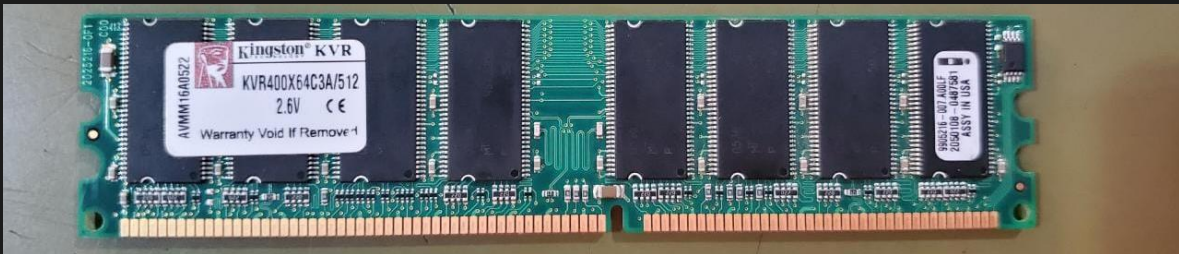
## REPORTE PRACTICA 3



Velocidad: KVR567D2N5/1G funciona a una velocidad de reloj de 667 MHz. La velocidad real de transferencia de datos es de 5,3 GB/s ( $667 \text{ MHz} \times 8 \text{ canales de datos} / 8 \text{ bits por canal}$ ).

Capacidad: Esta memoria tiene una capacidad total de 1 GB.

Latencia: El tiempo de latencia de KVR567D2N5/1G es CL5, lo que significa que su latencia CAS (Column Address Strobe) es de 5 ciclos de reloj. Esto representa la cantidad de tiempo que tarda la memoria en acceder a una columna de datos específica dentro del módulo de memoria.



## REPORTE PRACTICA 3





## REPORTE PRACTICA 3

